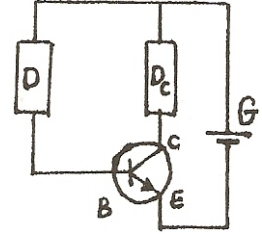


يتكون التركيب الممثل في الشكل التالي من :

- موصل اومي D_C مقاومته $R_C = 100\Omega$.
- موصل اومي D مقاومته R قابلة للضبط .
- مولد G قوته الكهرومحرركة $E = 4,5V$ ومقاومته الداخلية مهملة .
- ترانزستور T معامل تضخيمه $\beta = 100$ وتوتر الوصلة BE التي نعتبرها مؤمتلة هو $U_{BE} = 0,6V$.



- 1- عند ضبط المقاومة R على القيمة R_1 يشتغل الترانزستور في النظام الخطي، وتكون شدة التيار في دائرة المجمع $I_C = 30mA$.
- 1-1 اذكر انظمة اشتغال الترانزستور .
- 2-1 اوجد التوتر U_{CE} بين المربطين C و E .
- 3-1 احسب الشدة I_B للتيار المار في دائرة القاعدة .
- 4-1 استنتج قيمة المقاومة R_1 .
- 2- نضبط المقاومة R على قيمة معينة فيمر في دائرة المجمع تيار شدته $I_C = 45mA$. بين ان الترانزستور في حالة اشباع .